








	<h2 style="color: red;">SIHB12N60E-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHB12N60E-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 12A TO263</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHB12N60E-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 42282 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHB12N60E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A TO263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	42282 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	147W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	937pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk

SIHB12N60E-GE3 ist neu im Original, Suche SIHB12N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHB12N60E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHB12N60E-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SIHB12N50E</b> Vishay Precision Group SIHB12N50E VISHAY	 <b>SIHB12N60E</b> VISHAY SIHB12N60E VISHAY	 <b>SIHB12N50E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-263	 <b>SIHB12N60ET5-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO263
 <b>SIHB12N65E</b> Vishay Precision Group SIHB12N65E Vishay	 <b>SIHB12N50C-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 12A D2PAK	 <b>SIHB12N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO263	 <b>SIHB12N50E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-263

### heiße Teile

Mehr

SIHA12N60E	SIHA12N60E-E3	SIHA12N60E-E3	SIHA22N60E-E3	SIHA22N60E-E3
SIHA25N50E	SIHB12N50C	SIHB12N50C-E3	SIHB12N50C-E3	SIHB12N50E
SIHB12N60E	SIHB12N60E-GE3	SIHB12N65E	SIHB15N50E	SIHB15N60E-GE3
SIHB15N60E-GE3	SIHB15N65E	SIHB16N50C	SIHB16N50CTR-E3	SIHB18N60E
SIHB33N60E-GE3	SIHB33N60E-GE3	SIHD3N50D-GE3	SIHD3N50D-GE3	SIHD7N60E-GE3
SIHD7N60E-GE3	SIHF10N40D	SIHF10N40D-E3	SIHF10N40D-E3	SIHF12N50C
SIHF12N50C-E3	SIHF12N50C-E3	SIHF12N60E	SIHF12N60E-E3	SIHF12N60E-E3
SIHF12N60E-GE3	SIHF12N60E-GE3	SIHF12N60E-GE3	SIHF12N65E	SIHF15N60E
SIHF15N60E-E3	SIHF15N60E-E3	SIHF15N60E-EG3	SIHF15N60E-GE3	SIHF15N60E-GE3
SIHF16N50C	SIHF16N50C-E3	SIHF16N50C-E3	SIHF18N50C-E3	SIHF18N50C-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited